

**Ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց
դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոն**



Անուն, Ազգանուն

Անի Մովսիսյան

Ծննդյանվայրը, տարեթիվը

ք. Գյումրի 1989թ., դեկտեմբերի 28

Կրթությունը

բարձրագույն

2006-2012թ.

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ`

2012թ.-ից Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում ֆիզիկայի, տեխնոլոգիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների ամբիոնի «Ֆիզիկական էլեկտրոնիկայի» լաբորատորիայի լաբորանտ:

Վերջին հրատարակումները

1. Г.Р.Дрмеян, А.А. Мовсисян, “Рентгенографический метод определения толщины приповерхностного деформированного слоя кристаллических материалов”, “Вестник”, ГИУА. С. 69-73, Ереван 2013г.
2. H.R. Drmeyan. A.O. Aboyan, A.A. Movsisyan. X-Ray Interferometry Study of Deformation Fields in Silicon Crystals, Induced by a Constant Magnetic Field. Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2013, Vol. 7, №. 6, pp. 1056—1059.
3. Дрмеян Г.Р., Абоян А.О., Мовсисян А.А. Рентгено-интерферометрическое исследование полей деформаций в кристаллах кремния, возникающих под действием постоянного магнитного поля. Поверхность. 2013, № 11, с. 43-46.

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, ինտերնետային հասցե/

Ամուսնացած է:

Հեռախոս` (077) 503367
animovsisyan.89@mail.ru